

2SC1060, 2SC1061

シリコン NPN 三重拡散形

低周波電力増幅用

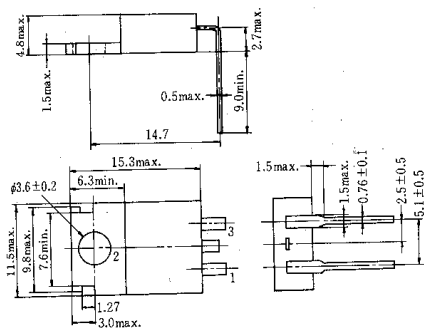
2SA670, 2SA671 とコンプリメンタリペア

SILICON NPN TRIPLE DIFFUSED

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SA670 and 2SA671

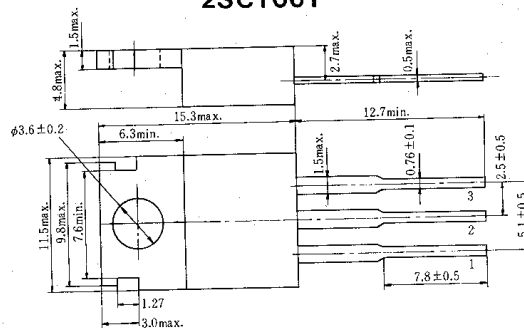
2SC1060



1. ベース: Base
2. コレクタ: Collector (フランジ) (Flange)
3. エミッタ: Emitter (Dimensions in mm)

(JEDEC TO-220AA)

2SC1061



(JEDEC TO-220AB)

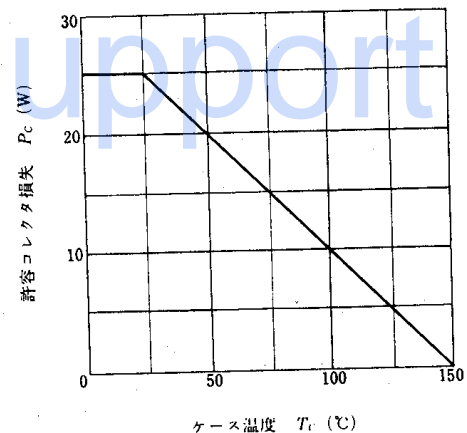
■ 絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SC1060, 2SC1061	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	50	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	50	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	4	V
コレクタ電流	I_c	3	A
許容コレクタ損失	P_c^*	25	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-55~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_c=25^\circ\text{C}$ における許容値

* Value at $T_c=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化 MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION CURVE



■ 電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min	typ	max	Unit
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	$I_c=5\text{mA}, I_E=0$	50	—	—	V
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	$I_c=50\text{mA}, R_{BE}=\infty$	50	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E=5\text{mA}, I_c=0$	4	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB}=20\text{V}, I_E=0$	—	—	100	μA
直流電流増幅率	h_{FE}^*	$V_{CE}=4\text{V}, I_c=1\text{A}$	35	—	320	
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_c=0.1\text{A}$	35	—	—	
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	$V_{CE}=4\text{V}, I_c=1\text{A}$	—	0.85	1.5	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_c=2\text{A}, I_B=0.2\text{A}$	—	0.5	1.0	V
2次破壊電流	I_M	$V_{CE}=40\text{V}, f=50\text{Hz}$ (Half Wave)	2.0	—	—	A
利得帯域幅積	f_T	$V_{CE}=4\text{V}, I_c=0.5\text{A}$	—	8	—	MHz

* 2SC1060, 2SC1061は h_{FE} の値により下記のように4区分し、現品に表示してあります。

* The 2SC1060 and 2SC1061 are grouped by h_{FE} as follows.

①	②	③	④
35~70	60~120	100~200	160~320